



**28 сентября – 3 октября 2009 г., Новосибирск - Томск**

## **ПЕРВОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ**

### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Девятая Российская конференция по физике полупроводников «Полупроводники-2009» состоится с 28 сентября по 3 октября 2009 г. в Академгородках Новосибирска (28-30 сентября) и Томска (1-3 октября). Эта конференция продолжит традицию предыдущих конференций, которые были проведены в Н. Новгороде (1993, 2001), Санкт-Петербурге (1996, 2003), Москве (1997, 2005), Новосибирске (1999) и Екатеринбурге (2007).

Новосибирск – третий по численности город России, административный центр Новосибирской области, один из крупнейших промышленных городов России, научная и культурная столица Сибири. Новосибирск – крупнейший центр академической науки в азиатской части России, в нем сосредоточен мощный научный потенциал СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН и НПО "Вектор". Новосибирский Академгородок является всемирно известным научным центром, уникальным не только по охвату областей человеческих знаний, но и по концентрации интеллектуальных, культурных и духовных сил, распространяющих свое влияние далеко за официальные рамки столицы Сибирского Отделения РАН. Академгородок был и остается уникальным «зеленым» примером в сибирской градостроительной практике, и его безусловное очарование – в негородских отношениях с природой.

Томск - старейший в Сибири город (основан в 1604 году), с уникальным сочетанием природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. По своему внешнему облику городские строения представляют собой смешение архитектурных стилей различных эпох. Историко-заповедная часть города сохранила неповторимость своеобразия городского ландшафта каменной застройки губернского города XIX - начала XX веков и деревянной застройки, украшенной старинной резьбой. Высокий образовательный и научно-технический потенциал Томской области поддерживается шестью государственными университетами, а также научно-исследовательскими институтами научных центров СО РАН и СО РАМН.

#### **ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:**

Отделение физических наук РАН,  
Сибирское отделение РАН,  
Научный совет РАН по физике полупроводников,  
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН,  
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,  
Томский государственный университет,  
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

#### **КОНФЕРЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ:**

Российская академия наук,  
Министерство образования и науки РФ,  
Российский фонд фундаментальных исследований,  
Международный научно – технический центр,  
Фонд некоммерческих программ «Династия».

## ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция посвящена фундаментальным проблемам физики полупроводников.

Основные разделы программы:

1. **Объемные полупроводники:** электрические и оптические свойства, релаксация носителей, сверхбыстрые явления, экситоны, фононы, фазовые переходы, упорядочение.
2. **Поверхность, пленки, слои:** эпитаксия, атомная и электронная структура поверхности, адсорбция и поверхностные реакции, процессы формирования (самоорганизации) нанокластеров, СТМ и АСМ, оптическая микроскопия ближнего поля.
3. **Гетероструктуры и сверхрешетки:** структурные и оптические свойства, электронный транспорт, микрорезонаторы.
4. **Двумерные системы:** структурные, электронные, магнитные свойства, туннелирование, локализация, фононы, плазмоны, высокочастотный транспорт, квантовый эффект Холла, корреляционные эффекты.
5. **Одномерные и нульмерные системы:** энергетический спектр, электронный транспорт, оптические свойства, локализация.
6. **Широкозонные материалы (SiC, GaN, II-VI и др.):** рост, оптические и электронные свойства.
7. **Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм.**
8. **Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры):** примеси с мелкими и глубокими уровнями, магнитные примеси, структурные дефекты, неупорядоченные полупроводники.
9. **Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон).**
10. **Органические полупроводники, молекулярные системы.**
11. **Углеродные наноматериалы.**
12. **Метаматериалы и фотонные кристаллы.**
13. **Полупроводниковые приборы и устройства:** технология, методы исследования, наноприборы.

Председатель конференции  
Асеев А.Л.

СО РАН, ИФП СО РАН

## **ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ**

Председатель

И.В. Кукушкин

ИФТТ РАН, Черноголовка

Ученый секретарь

И.П. Акимченко

ОФН РАН, Москва

Ж.И. Алферов

С.-Пт. ФТ НОЦ РАН, С.-Петербург

А.А. Андронов

ИФМ РАН, Н. Новгород

А.Л. Асеев

ИФП СО РАН, Новосибирск

В.А. Волков

ИРЭ РАН, Москва

С.В. Гапонов

ИФМ РАН, Н. Новгород

А.А. Гиппиус

ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва

А.В. Двуреченский

ИФП СО РАН, Новосибирск

В.С. Днепровский

МГУ, Москва

А.Г. Забродский

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург

С.В. Зайцев-Зотов

ИРЭ РАН, Москва

В.В.Кведер

ИФТТ РАН, Черноголовка

Л.В. Келдыш

ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва

Н.Г. Колин

ГНЦ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, Обнинск

Ю.В. Копаев

ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва

П.С. Копьев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург

З.Ф. Красильник

ИФМ РАН, Н. Новгород

Г.Я.Красников

ОАО «НИИМЭ и Микрон», Москва

Ф.А.Кузнецов

ИНХ СОАН, Новосибирск

В.Д. Кулаковский

ИФТТ РАН, Черноголовка

Ю.Г. Кусраев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург

М.Г. Мильвидский

ГИРЕДМЕТ, Москва

И.Г. Неизвестный

ИФП СО РАН, Новосибирск

В.И. Окулов

ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

А.А.Орликовский

ФТИ РАН, Москва

Я.Е. Покровский

ИРЭ РАН, Москва

S.J. Pearton.

University of Florida, Gainesville, USA

А.А. Саранин

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток

Н.Н. Сибельдин

ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва

Р.А. Сурис

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург

P. Siffert

EMRS, Strassbourg, France

А.С. Терехов

ИФП СО РАН, Новосибирск

В.Б. Тимофеев

ИФТТ РАН, Черноголовка

В.В. Устинов

ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Д.Р. Хохлов

МГУ, Москва

А.В. Чаплик

ИФП СО РАН, Новосибирск

В.И. Шашкин

ИФМ РАН, Н. Новгород

### **Адреса и контакты Программного комитета**

Москва, 119991, Ленинский проспект, 53,

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,

Акимченко Ирина Петровна – ученый секретарь Программного комитета

Электронная почта: [akim@gpad.ac.ru](mailto:akim@gpad.ac.ru)

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель А.В.Двуреченский	ИФП СО РАН, Новосибирск
Зам. председателя Г.В.Майер С.Г.Псахье	ТГУ, Томск ИФПМ СО РАН, Томск
Ученый секретарь Л.А.Ильина	ИФП СО РАН, Новосибирск
В.Н.Брудный	ТГУ, Томск
П.Т.Девяткин	ИФП СО РАН, Новосибирск
В.В.Емцев	ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург
К.С.Журавлев	ИФП СО РАН, Новосибирск
И.В.Ивонин	ТГУ, Томск
А.П.Казак	ФГУП «НПП «Восток»
А.А.Карпушин	Президиум СО РАН, Новосибирск
А.Э.Климов	ИФП СО РАН, Новосибирск
П.С.Копьев	ФТИ им.А.Ф.Иоффе, С.-Петербург
З.Ф.Красильник	ИФМ РАН, Н. Новгород
Ф.А.Кузнецов	ИНХ СО РАН, Новосибирск
Г.Л.Курышев	ИФП СО РАН, Новосибирск
О.В. Лapidус	МНТЦ, Москва
А.В.Латышев	ИФП СО РАН, Новосибирск
В.И. Окулов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.В. Панин	ИФПМ СО РАН, Томск
В.Я.Принц	ИФП СО РАН, Новосибирск
А.Г.Погосов	ИФП СО РАН, Новосибирск
О.П.Пчеляков	ИФП СО РАН, Новосибирск
Н.Н. Сибельдин	ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва
Ю.Г.Сидоров	ИФП СО РАН, Новосибирск
Э.В.Скубневский	ИФП СО РАН, Новосибирск

### Адреса и контакты Оргкомитета

Новосибирск, 630090, проспект академика Лаврентьева 13,  
Институт физики полупроводников СО РАН,  
Ильина Лариса Александровна – ученый секретарь Оргкомитета,  
Тычинская Светлана Анатольевна,  
Электронная почта: [semicond\\_2009@isp.nsc.ru](mailto:semicond_2009@isp.nsc.ru)  
Телефон: (383)3333260,  
Факс: (383)3332771

Сайт конференции в Интернете: [http://lib.isp.nsc.ru/semi\\_2009/](http://lib.isp.nsc.ru/semi_2009/)

## РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Участники конференции могут зарегистрироваться на сайте конференции: [http://lib.isp.nsc.ru/semi\\_2009/](http://lib.isp.nsc.ru/semi_2009/). Возможна также регистрация по электронной почте. Заполните анкету в Microsoft Word и отправьте на адрес: [semicond\\_2009@isp.nsc.ru](mailto:semicond_2009@isp.nsc.ru) со следующими данными, включенными в Subject line: **Semicond2009, registr, familyname**, где familyname – это Ваша фамилия по-английски.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Тезисы докладов, подготовленные в соответствии с Инструкцией, должны быть представлены не позднее 30 марта 2009 г. с помощью:

- интерактивной системы через сайт конференции [http://lib.isp.nsc.ru/semi\\_2009/](http://lib.isp.nsc.ru/semi_2009/)
- или по электронной почте в адрес программного комитета: [akim@gpad.ac.ru](mailto:akim@gpad.ac.ru) и копия в адрес организационного комитета: [semicond\\_2009@isp.nsc.ru](mailto:semicond_2009@isp.nsc.ru) со следующими данными, включенными в Subject line: **Semicond2009, abstract, <номер тематики>, familyname**, где familyname-это Ваша фамилия по-английски.

Инструкция по подготовке и представлению тезисов находится на сайте конференции. Факт получения электронной версии тезисов будет подтверждаться электронным сообщением.